

# 日程表 (会場別1)

3月15日(日)・16日(月)

会場名		収容人数	2026年3月15日(日)		2026年3月16日(月)	
			午前	午後	午前	午後
70A-101 (70周年記念講堂)		700	09:00 ~ 12:20 T13 原子層プロセス (ALP : Atomic Layer Process) の解析技術と応用技術 (3)	13:30 ~ 18:00 T13 原子層プロセス (ALP : Atomic Layer Process) の解析技術と応用技術 (3)	09:00 ~ 12:00 T24 人間 × AI × ロボティクスが拓く自律材料研究のフロンティア	13:30 ~ 17:40 T24 人間 × AI × ロボティクスが拓く自律材料研究のフロンティア
西9号館	W9-222	287	11:00 ~ 12:00 授賞式(論文誌編集員貢献授賞式, 論文賞, 講演奨励賞)	16:00 ~ 18:00 授賞式(業績賞, D&I賞, 光・量子エレクトロニクス業績賞(宅間宏賞), 化合物半導体エレクトロニクス業績賞(赤崎勇賞), 光工学業績賞・功績賞(高野榮一賞), シリコン系半導体エレクトロニクス業績賞(名取研二業績賞)・若手奨励賞(名取研二若手奨励賞)・高専活性化奨励賞(名取研二高専活性化奨励賞)		13:30 ~ 18:00 T1 Lab to Fab 2 : 量産化とグリーン化を突破するための半導体研究
	W9-323	72	10:30 ~ 11:45 22.1 合同セッションM「フォノンエンジニアリング」	13:30 ~ 17:15 22.1 合同セッションM「フォノンエンジニアリング」		13:00 ~ 18:30 13.2 探索的材料物性・基礎物性
	W9-324	150		13:30 ~ 17:15 21.1 合同セッションK「ワイドギャップ酸化物半導体材料・デバイス」	09:00 ~ 12:15 21.1 合同セッションK「ワイドギャップ酸化物半導体材料・デバイス」	13:30 ~ 18:30 21.1 合同セッションK「ワイドギャップ酸化物半導体材料・デバイス」
	W9-325	81	09:30 ~ 11:45 11.1 基礎物性	13:30 ~ 16:45 11.1 基礎物性	10:00 ~ 12:00 22.1 合同セッションM「フォノンエンジニアリング」	13:30 ~ 16:15 11.2 薄膜, 厚膜, テープ作製プロセスおよび結晶成長
	W9-326	90		13:30 ~ 17:45 7.1 X線技術	09:00 ~ 11:45 3.12 半導体光デバイス	13:45 ~ 16:45 3.12 半導体光デバイス
	W9-327	55			09:00 ~ 10:30 16.2 エナジーハーベスティング	13:30 ~ 18:00 16.1 基礎物性・評価・プロセス・デバイス
西8号館	W8E-101	160	09:00 ~ 11:00 13.3 絶縁膜技術	13:30 ~ 17:15 13.3 絶縁膜技術	09:30 ~ 12:00 13.7 化合物及びパワーデバイス・プロセス技術・評価	13:30 ~ 18:00 13.7 化合物及びパワーデバイス・プロセス技術・評価
	W8E-307	77		13:30 ~ 17:45 15.6 IV族系化合物 (SiC)	09:00 ~ 11:45 15.7 結晶評価, 不純物・結晶欠陥	14:00 ~ 17:30 15.1 バルク結晶成長
	W8E-308	61			11:00 ~ 12:00 15.2 II-VI族結晶および多元系結晶	13:30 ~ 15:45 11.4 アナログ応用および関連技術
西2号館	W2-401	255	09:00 ~ 11:30 15.4 III-V族窒化物結晶	13:00 ~ 17:45 15.4 III-V族窒化物結晶	09:00 ~ 11:30 15.4 III-V族窒化物結晶	13:00 ~ 17:45 15.4 III-V族窒化物結晶
	W2-402	108	10:00 ~ 11:45 15.5 IV族結晶, IV-IV族混晶	13:30 ~ 16:45 15.5 IV族結晶, IV-IV族混晶	09:00 ~ 11:45 12.6 ナノバイオテクノロジー	13:30 ~ 18:15 12.6 ナノバイオテクノロジー
西講義棟1	WL1-201	269	09:00 ~ 12:00 12.6 ナノバイオテクノロジー	13:30 ~ 17:15 T19 有機分子のフィジカル空間とサイバー空間の狭間で; 今, シミュレーションで解決すべき有機デバイスの課題	09:00 ~ 12:00 3.1 光学基礎・光学新領域	13:30 ~ 18:20 T7 光熱変換による物理化学と量子生命科学のイノベーション
	WL1-301	273	09:00 ~ 12:00 12.7 医用工学・バイオチップ	13:30 ~ 18:20 T16 ナノバイオテクノロジー分野におけるインフォマティクス技術の応用	09:00 ~ 12:00 12.7 医用工学・バイオチップ	13:30 ~ 18:30 T14 磁気科学と医工融合が拓く次世代バイオメディカル
	WL1-401	269		13:30 ~ 17:30 NT2【一般公開】国際性あるダイバーシティ実現へ: 学術・産業の場におけるダイバーシティ&インクルージョンを考える		13:30 ~ 16:25 NT1【一般公開】就活生必見! 理科学の知と技術者の挑戦 ~ AI×半導体の新世界 ~
西講義棟2	WL2-101	108	09:00 ~ 11:45 6.3 酸化物エレクトロニクス	13:30 ~ 17:00 6.3 酸化物エレクトロニクス	09:00 ~ 11:45 6.4 薄膜新材料	13:30 ~ 16:30 6.4 薄膜新材料
	WL2-201	143	09:30 ~ 12:00 3.10 フォトニック構造・現象	13:30 ~ 16:15 3.10 フォトニック構造・現象	09:30 ~ 12:00 3.10 フォトニック構造・現象	13:30 ~ 16:15 3.10 フォトニック構造・現象
	WL2-301	143	09:30 ~ 12:00 3.7 光計測技術・機器	13:30 ~ 16:00 3.7 光計測技術・機器	09:30 ~ 12:00 3.7 光計測技術・機器	13:30 ~ 17:45 3.8 テラヘルツ全般
	WL2-401	143		13:30 ~ 17:15 6.2 カーボン系薄膜	09:30 ~ 11:45 6.2 カーボン系薄膜	13:30 ~ 17:45 9.4 熱電変換
SL-101 (南講義棟)		165		13:45 ~ 18:30 CS.4 6.1 強誘電体薄膜、15.4 III-V族窒化物結晶のコードシェアセッション	09:30 ~ 12:45 KS4 量子エネルギー変換研究会	14:00 ~ 18:30 KS4 量子エネルギー変換研究会
南2号館	S2-201	75		16:30 ~ 18:15 10.5 磁場応用	09:00 ~ 12:30 10.4 半導体・トポロジカル・超伝導・強相関スピントロニクス	14:00 ~ 17:00 10.4 半導体・トポロジカル・超伝導・強相関スピントロニクス
	S2-202	75	09:00 ~ 11:45 CS.1 2.3 加速器技術・加速器質量分析・ビーム分析、7.4 イオンビーム一般のコードシェアセッション	14:00 ~ 16:45 CS.1 2.3 加速器技術・加速器質量分析・ビーム分析、7.4 イオンビーム一般のコードシェアセッション		14:00 ~ 18:00 2.2 発生装置・検出器開発・計測技術
	S2-203	186	09:30~12:00 ※有料※ チュートリアル「新スピントロニクス入門ースピ流から最新の基礎・応用までー」	13:30 ~ 16:55 T5 光とキラリティー : その科学と応用	09:00 ~ 11:45 13.5 デバイス/配線/集積化技術	14:00 ~ 18:45 13.5 デバイス/配線/集積化技術
	S2-204	173	09:30~12:30 ※有料※ チュートリアル「インフォマティクス応用入門Ⅲ 実践編」	13:30 ~ 18:30 23.1 合同セッションN「インフォマティクス応用」	09:15 ~ 12:00 CS.2 3.8 テラヘルツ全般、3.11 ナノ領域光科学・近接場光学のコードシェアセッション	13:30 ~ 17:50 T6 実用化目前のメタサーフィス
南4号館	S4-201	102	09:00 ~ 12:00 3.1 光学基礎・光学新領域	14:00 ~ 17:15 3.14 Optics and Photonics English Session	09:00 ~ 12:30 10.2 スピン基盤技術・萌芽的デバイス技術	14:00 ~ 17:15 10.2 スピン基盤技術・萌芽的デバイス技術 17:15 ~ 19:00 10.3 スピンデバイス・磁気メモリ・フロンティア技術
	S4-202	72	09:00 ~ 11:30 9.3 ナノエレクトロニクス	14:00 ~ 16:45 9.2 ナノ粒子・ナノワイヤ・ナノシート	10:00 ~ 12:15 9.2 ナノ粒子・ナノワイヤ・ナノシート	14:00 ~ 16:45 9.1 誘電材料・誘電体
	S4-203	72	09:00 ~ 12:00 13.4 Si系プロセス・Si系薄膜・MEMS・装置技術	14:00 ~ 18:15 13.4 Si系プロセス・Si系薄膜・MEMS・装置技術	09:00 ~ 12:15 7.2 電子ビーム応用	14:00 ~ 16:30 7.2 電子ビーム応用

# 日程表（会場別1）

3月17日(火)・18日(水)

会場名		収容人数	2026年3月17日(火)		2026年3月18日(水)	
			午前	午後	午前	午後
70A-101 (70周年記念講堂)		700		13:30 ~ 17:40 T22【一般公開】宇宙開発から宇宙産業へ：ビジネス参入へのヒントと最新の技術動向		
西9号館	W9-222	287				
	W9-323	72	09:30 ~ 11:30 11.3 臨界電流、超伝導パワー応用	13:30 ~ 16:15 CS.7 6.5 表面物理・真空、7.5 原子・分子線およびビーム関連新技術のコードシェアセッション	09:00 ~ 11:45 CS.7 6.5 表面物理・真空、7.5 原子・分子線およびビーム関連新技術のコードシェアセッション	
	W9-324	150	09:15 ~ 12:00 21.1 合同セッションK「ワイドギャップ酸化物半導体材料・デバイス」	13:30 ~ 17:45 21.1 合同セッションK「ワイドギャップ酸化物半導体材料・デバイス」	09:00 ~ 12:00 KS.1 固体量子センサ研究会	13:30 ~ 16:15 KS.1 固体量子センサ研究会
	W9-325	81	10:00 ~ 11:30 16.3 シリコン系太陽電池	13:30 ~ 16:30 16.3 シリコン系太陽電池		
	W9-326	90	09:00 ~ 12:15 3.5 超高速・高強度レーザー	13:30 ~ 18:15 3.5 超高速・高強度レーザー	09:00 ~ 11:30 3.5 超高速・高強度レーザー	
	W9-327	55				
西8号館	W8E-101	160	09:00 ~ 12:00 13.7 化合物及びパワーデバイス・プロセス技術・評価	13:30 ~ 18:30 13.7 化合物及びパワーデバイス・プロセス技術・評価	09:00 ~ 12:15 13.7 化合物及びパワーデバイス・プロセス技術・評価	13:30 ~ 16:15 13.7 化合物及びパワーデバイス・プロセス技術・評価
	W8E-307	77	09:15 ~ 12:00 15.3 III-V族エピタキシャル結晶・エピタキシーの基礎	13:30 ~ 16:15 15.3 III-V族エピタキシャル結晶・エピタキシーの基礎		
	W8E-308	61		13:30 ~ 17:45 11.5 接合、回路作製プロセスおよびデジタル応用		
西2号館	W2-401	255	09:00 ~ 11:30 15.4 III-V族窒化物結晶	13:30 ~ 18:30 15.4 III-V族窒化物結晶	09:00 ~ 12:00 15.4 III-V族窒化物結晶	13:30 ~ 16:30 12.7 医用工学・バイオチップ
	W2-402	108	10:00 ~ 11:15 12.1 作製・構造制御	13:30 ~ 17:30 12.1 作製・構造制御		
西講義棟1	WL1-201	269		13:30 ~ 18:00 NT3【一般公開】半導体テクノロジーはウェルビーイングを向上させられるのか？	09:30 ~ 11:45 6.4 薄膜新材料	13:00 ~ 16:45 T9 技術イノベーションを加速する薄膜新材料とデバイス・プロセスの新展開
	WL1-301	273	09:00 ~ 12:00 12.7 医用工学・バイオチップ	13:30 ~ 18:15 T18 バイオ・エレクトロニクス・フォトリソの融合によるニューロモルフィックコンピューティング		
	WL1-401	269		13:30 ~ 17:20 T23 時空間可換性が拓く非平衡材料の新展開		
西講義棟2	WL2-101	108	09:30 ~ 12:00 3.2 情報フォトリソ・画像工学	13:30 ~ 16:15 CS.6 6.3 酸化物エレクトロニクス、6.4 薄膜新材料のコードシェアセッション	09:00 ~ 12:00 13.8 光物性・発光デバイス	
	WL2-201	143	09:00 ~ 12:00 3.11 ナノ領域光科学・近接場光学	13:30 ~ 18:00 3.11 ナノ領域光科学・近接場光学	09:00 ~ 11:45 3.11 ナノ領域光科学・近接場光学	13:15 ~ 17:00 3.11 ナノ領域光科学・近接場光学
	WL2-301	143	09:00 ~ 12:00 3.1 光学基礎・光学新領域	13:30 ~ 17:45 3.7 光計測技術・機器	09:00 ~ 12:00 3.8 テラヘルツ全般	13:30 ~ 16:30 3.8 テラヘルツ全般
	WL2-401	143	09:00 ~ 12:00 3.13 シリコンフォトリソ・光電融合集積・光制御	13:30 ~ 17:15 3.13 シリコンフォトリソ・光電融合集積・光制御	09:00 ~ 12:00 3.13 シリコンフォトリソ・光電融合集積・光制御	
SL-101 (南講義棟)		165	09:30 ~ 12:15 KS4 量子エネルギー変換研究会	13:30 ~ 15:45 KS4 量子エネルギー変換研究会		
南2号館	S2-201	75	09:00 ~ 12:45 13.4 Si系プロセス・Si系薄膜・MEMS・装置技術	14:00 ~ 18:00 2.4 ライフサイエンス・医療・宇宙地球環境・放射線教育	09:00 ~ 11:45 10.1 新物質・新機能創成（作製・評価技術）	13:30 ~ 15:45 10.1 新物質・新機能創成（作製・評価技術）
	S2-202	75	09:00 ~ 12:30 2.2 発生装置・検出器開発・計測技術	14:00 ~ 15:30 2.1 放射線物理・材料開発・材料特性評価	09:00 ~ 11:30 KS.2 量子情報工学研究会	14:00 ~ 16:45 KS.2 量子情報工学研究会
	S2-203	186	09:00 ~ 12:15 13.5 デバイス／配線／集積化技術	13:30 ~ 17:55 T11 次世代電子源と電子ビーム技術の新展開	09:00 ~ 12:00 13.5 デバイス／配線／集積化技術	14:00 ~ 17:00 13.5 デバイス／配線／集積化技術
	S2-204	173	09:00 ~ 12:30 23.1 合同セッションN「インフォマティクス応用」	13:30 ~ 18:30 23.1 合同セッションN「インフォマティクス応用」	11:30 ~ 13:00 23.1 合同セッションN「インフォマティクス応用」	14:00 ~ 16:45 23.1 合同セッションN「インフォマティクス応用」
南4号館	S4-201	102	09:00 ~ 12:30 6.6 プロブ顕微鏡	14:00 ~ 18:00 CS.5 6.2 カーボン系薄膜、KS1 固体量子センサ研究会のコードシェアセッション	10:30 ~ 12:00 3.6 レーザープロセッシング	14:00 ~ 17:00 3.6 レーザープロセッシング
	S4-202	72	09:00 ~ 11:45 7.3 微細パターン・微細構造形成技術	14:00 ~ 17:15 9.5 新機能材料・新物性		
	S4-203	72	09:00 ~ 12:00 13.1 Si系基礎物性・表面界面・シミュレーション	14:10 ~ 17:15 3.9 光子量子物理・技術	09:00 ~ 10:45 3.9 光子量子物理・技術	

# 日程表（会場別2）

3月15日(日)・16日(月)

会場名		収容人数	2026年3月15日(日)		2026年3月16日(月)	
			午前	午後	午前	午後
本館	M-B07	200		13:30～16:45 T3 廃炉の未来を切り拓く放射線計測技術 ー福島第一原子力発電所における挑戦と進展ー	09:00～11:45 9.1 誘電材料・誘電体	13:30～17:15 T2 組織における人材育成と技術伝承：現状と今後の展望
	M-B104	96		14:00～18:15 KS4 量子エネルギー変換研究会	09:30～12:30 6.6 プローブ顕微鏡	14:00～19:00 12.4 有機EL・トランジスタ・フレキシブルデバイス
	M-101	72		14:00～17:00 17.1 カーボンナノチューブ、他のナノカーボン材料	09:00～12:15 17.1 カーボンナノチューブ、他のナノカーボン材料	13:30～18:30 13.9 化合物太陽電池
	M-103	98	09:45～12:00 ※有料※ チュートリアル「二次元材料トランジスタの基礎技術」	14:30～17:00 ※有料※ チュートリアル「半導体製造における低温プラズマプロセスの基礎と応用」	09:00～11:30 12.3 機能材料・萌芽的デバイス	14:00～17:15 12.3 機能材料・萌芽的デバイス
	M-107	75		14:00～18:00 8.4 プラズマライフサイエンス	09:30～12:15 13.6 ナノ構造・量子現象・ナノ量子デバイス	14:00～17:15 13.6 ナノ構造・量子現象・ナノ量子デバイス
	M-110	80	09:00～12:00 3.3 生体・医用光学	14:00～17:15 3.3 生体・医用光学	09:30～12:00 3.2 情報フォトンクス・画像工学	14:00～17:45 3.2 情報フォトンクス・画像工学
	M-123	112	09:00～12:30 FS.1 フォーカストセッション「AIエレクトロニクス」	14:00～16:15 FS.1 フォーカストセッション「AIエレクトロニクス」	09:00～12:30 FS.1 フォーカストセッション「AIエレクトロニクス」	14:00～16:15 FS.1 フォーカストセッション「AIエレクトロニクス」
	M-124	182	09:00～12:30 13.5 デバイス／配線／集積化技術	14:00～18:15 17.3 層状物質	09:00～12:15 12.5 有機・ハイブリッド太陽電池	14:00～18:30 12.5 有機・ハイブリッド太陽電池
	M-135	54	09:30～12:00 1.6 超音波	14:00～15:45 1.6 超音波	10:00～12:15 1.1 応用物理一般・学際領域	14:00～18:00 1.5 計測技術・計測標準
	M-178	299		13:30～18:20 T4 誤り耐性量子計算の最前線と展望	09:00～12:00 17.3 層状物質	13:30～17:10 T21 次世代センシング・通信を拓く微細加工・MEMS技術の新展開
	M-278	286		13:30～16:45 T17 ナノテクノロジーを駆使したバイオセンサーと2次元材料の最前線 ヒト感染性ウイルスを迅速に検出可能なグラフェンFETセンサーによるパンデミックのない社会の実現 -	09:00～10:45 6.1 強誘電体薄膜	13:30～16:25 T8 分布型音響センサ（DAS）による社会インフラの見える化と防災活用
	M-374	286		13:30～18:00 T20 光機能材料と界面制御によるエネルギー変換研究の新展開	11:00～11:45 8.7 プラズマエレクトロニクス分科内招待講演	13:30～17:55 T12 プラズマが誘起する植物応答
屋内運動場	PA (1F アリーナ)		09:30～11:00 8.4 プラズマライフサイエンス 8.5 プラズマ現象・新応用・融合分野 12.5 有機・ハイブリッド太陽電池	14:30～16:00 3.11 ナノ領域光科学・近接場光学 3.12 半導体光デバイス	09:30～11:00 11 超伝導 13.2 探索的材料物性・基礎物性 13.3 絶縁膜技術 13.4 Si系プロセス・Si系薄膜・MEMS・装置技術 13.9 化合物太陽電池	14:30～16:00 15.2 II-VI族結晶および多元系結晶 15.3 III-V族エピタキシャル結晶・エピタキシーの基礎 15.4 III-V族窒化物結晶 15.5 IV族結晶、IV-IV族混晶 15.7 結晶評価、不純物・結晶欠陥 22.1 合同セッションM「フォノンエンジニアリング」
			11:30～13:00 2 放射線 16 非晶質・微結晶	16:30～18:00 3.7 光計測技術・機器 3.10 フォトニック構造・現象	11:30～13:00 6.1 強誘電体薄膜 12.1 作製・構造制御 15.1 バルク結晶成長	16:30～18:00 17 ナノカーボン・二次元材料(1/2)
	PB (B1F 武道場)		09:30～11:00 13.5 デバイス／配線／集積化技術 13.7 化合物及びパワーデバイス・プロセス技術・評価 15.6 IV族系化合物（SiC）	14:30～16:00 10 スピントロニクス・マグネティクス	09:30～11:00 3.3 生体・医用光学 3.4 レーザー装置・材料 3.5 超高速・高強度レーザー 3.8 テラヘルツ全般 3.9 光子量子物理・技術 3.13 シリコンフォトンクス・光電融合集積・光制御 3.14 Optics and Photonics English Session	14:30～16:00 6.2 カーボン系薄膜 6.6 プローブ顕微鏡 KS.1 固体量子センサ研究会
				16:30～18:00 1 応用物理学一般		16:30～18:00 17 ナノカーボン・二次元材料(2/2)

日程表 (会場別2)

3月17日(火)・18日(水)

会場名	2026年3月17日(火)		2026年3月18日(水)	
	午前	午後	午前	午後
M-B07	09:00 ~ 11:30 KS.2 量子情報工学研究会	13:30 ~ 17:40 T10 半導体評価技術の最前線		
M-B104	09:00 ~ 12:00 12.3 機能材料・萌芽的デバイス	14:00 ~ 17:00 12.3 機能材料・萌芽的デバイス	09:00 ~ 11:45 12.4 有機EL・トランジスタ・フレキシブルデバイス	13:30 ~ 15:45 12.4 有機EL・トランジスタ・フレキシブルデバイス
M-101		14:00 ~ 19:00 17.2 グラフェン	10:00 ~ 12:30 12.8 特定テーマ：有機無機ハイブリッドペロブスカイトの光電物性・デバイス作製・構造制御	14:00 ~ 16:00 12.8 特定テーマ：有機無機ハイブリッドペロブスカイトの光電物性・デバイス作製・構造制御
M-103	09:00 ~ 12:30 8.2 プラズマ成膜・エッチング・表面処理	14:00 ~ 17:15 8.2 プラズマ成膜・エッチング・表面処理	09:00 ~ 12:30 8.1 プラズマ生成・診断	14:00 ~ 15:45 8.1 プラズマ生成・診断 16:00 ~ 16:45 8.6 Plasma Electronics English Session
M-107		14:00 ~ 18:15 8.5 プラズマ現象・新応用・融合分野	09:00 ~ 10:30 8.3 プラズマナノテクノロジー	
M-110	09:00 ~ 12:30 3.4 レーザー装置・材料	14:00 ~ 17:45 3.4 レーザー装置・材料		
M-123	09:00 ~ 12:15 12.4 有機EL・トランジスタ・フレキシブルデバイス	14:00 ~ 18:45 12.2 評価・基礎物性	09:00 ~ 12:30 12.2 評価・基礎物性	
M-124	09:00 ~ 12:00 12.5 有機・ハイブリッド太陽電池	14:00 ~ 15:30 12.5 有機・ハイブリッド太陽電池		
M-135	09:00 ~ 11:45 1.3 新技術・複合新領域	14:00 ~ 17:30 1.4 エネルギー変換・貯蔵・資源・環境	09:00 ~ 11:30 1.2 教育	
M-178	09:00 ~ 12:30 17.3 層状物質	14:00 ~ 18:00 17.3 層状物質	09:00 ~ 12:00 17.3 層状物質	14:00 ~ 16:00 17.3 層状物質
M-278	09:00 ~ 12:30 CS.3 6.1 強誘電体薄膜、13.3 絶縁膜技術、13.5 デバイス／配線／集積化技術のコードシェアセッション	14:00 ~ 18:15 6.1 強誘電体薄膜		
M-374	09:00 ~ 12:00 10.3 スピンデバイス・磁気メモリ・ストレージ技術	13:30 ~ 17:35 T15 AI時代における大規模ストレージ・不揮発性メモリ技術の将来展望		
PA (1F アリーナ)	09:30~11:00 9 応用物性	14:30~16:00 3.1 光学基礎・光学新領域 3.2 情報フォトニクス・画像工学 3.6 レーザープロセッシング	09:30~11:00 23.1 合同セッションN「インフォマティクス応用」 FS.1 フォーカストセッション「AIエレクトロニクス」	
	11:30~13:00 6.4 薄膜新材料 6.5 表面物理・真空	16:30~18:00 13.1 Si系基礎物性・表面界面・シミュレーション 13.6 ナノ構造・量子現象・ナノ量子デバイス 13.8 光物性・発光デバイス KS4 量子エネルギー変換研究会	11:30~13:00 21.1 合同セッションK「ワイドギャップ酸化物半導体材料・デバイス」	
PB (B1F 武道場)		14:30~16:00 12.4 有機EL・トランジスタ・フレキシブルデバイス 12.8 特定テーマ：有機無機ハイブリッドペロブスカイトの光電物性・デバイス作製・構造制御	09:30~11:00 12.3 機能材料・萌芽的デバイス 12.7 医用工学・バイオチップ	
	11:30~13:00 6.3 酸化物エレクトロニクス 12.2 評価・基礎物性 12.6 ナノバイオテクノロジー	16:30~18:00 8.1 プラズマ生成・診断 8.3 プラズマナノテクノロジー	11:30~13:00 7 ビーム応用 8.2 プラズマ成膜・エッチング・表面処理	